# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-170216

(43)Date of publication of application: 14.06.2002

(51)Int.Cl.

G11B 5/667 **G11B** 5/738

G11B 5/84

(21)Application number: 2000-367463

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

01.12.2000

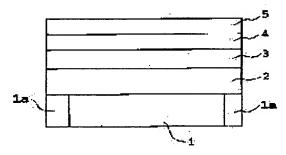
(72)Inventor: TAKENOIRI SHUNJI

## (54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND METHOD OF MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a perpendicular magnetic recording medium in which spike noise generated by providing a soft magnetic backing layer can be suppressed and which can be massproduced and to provide its manufacturing method. SOLUTION: The perpendicular magnetic recording medium has a structure wherein at least the soft magnetic backing layer, a magnetic recording layer, a protective film and a liquid lubricating material layer are successively laminated on a non-magnetic substrate, and the non-magnetic substrate has a soft magnetic

layer formed on its outer and inner peripheral side surfaces.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開母号 特開2002-170216 (P2002-170216A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51) Int.CL'		級別配号	FI		テーマコー)*(参考)
GIIB	5/667		G11B	<b>5/667</b>	5D006
	5/738			5/738	5D112
	5/84			5/84	Z

#### 審査請求 京請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

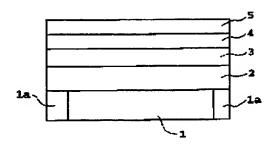
(21)出顧器号	特度2000-367463( P2000-367463)	(71)出顧人 000005234 含士領機株式会社
(22)出題日	平成12年12月 1日(2000, 12.1)	神奈川県川崎市川崎区田辺新田1巻1号
(ve)[HBHH	TRUE 412/3 1 EJ (2000. 12.1)	がおいめい (14) (14) (14) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15
		(72) 班明者 竹野入 俊司
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1 巻 1 号
		宫土田德株式会社内
		(74)代建人 100077481
		<b> </b>
		Pターム(参考) 50008 8807 CA91 CA03 CA95 CA96
		CB07 DA03 EA05 FA09
		50112 AAG3 AA24 BDD1 DOG4 FB14

## (54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 敏磁性裏打ち唇を設けることによるスパイクノイズの抑制。 および大量生産が可能な垂直磁気記録媒体およびその製造方法の提供。

【解決手段】 非磁性基体上に少なくとも軟磁性裏打ち層、磁気記錄器。保護順、および液体潤滑材層が順次額層された構造を有しており、該非磁性基体が、外周および内周側面に軟磁性層を形成している垂直磁気記録媒体。



#### 【特許請求の範囲】

【語求項1】 非磁性基体上に少なくとも軟強性裏打ち 囲、磁気記録器、保護膜、および液体調料材圏が順次積 層された構造を育する垂直磁気記録媒体であって、前記 非磁性基体は、外国および内園側面に軟磁性圏を形成し ていることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

1

【語求項2】 前記欹磁性裏打ち層は、磁化容易軸が半 径方向に平行に配向していることを特徴とする語求項1 に記載の垂直磁気記録媒体。

【語求項3】 非磁性基体上に少なくとも敏磁性裏打ち 恩. 磁気記錄器、保護膜、および液体調件材度が順次論 層された構造を有する金直磁気記錄媒体であって、前記 敏磁性裏打ち層が、軟磁性下層、非磁性層、および軟磁性上層の順に積層した3層構造をしており、前記非磁性 屋は、前記非磁性基体の内周より大きい内周と、前記非磁性基体の外周より小さい外周とを有しており、かつ外 園および内園側面に軟磁性層を形成しており、前記非磁性上層と非磁性下層とが、前記非磁性層の外周および内 園側面に設けられた軟磁性層を介して接続することを特 磁とする金直磁気記錄媒体。

【詰求項4】 前記欹磁性上層および軟磁性下層は、磁 化容易輪が半径方向に平行に配向していることを特徴と する請求項3に記載の垂直磁気記録媒体。

【語求項5】 非磁性基体上に少なくとも軟磁性裏打ち層. 磁気記録層、保護順、および液体調料材層が順次荷層された構造を有する金直磁気記録媒体の製造方法であって、非磁性基体の外周および内周側面に軟磁性層を設ける工程と、前記非磁性基体および軟磁性層上に軟磁性裏打ち層を形成し、同時に軟磁性裏打ち層に基体の半径方向に平行な数10~数100 Gaussの磁場を印加する工程と、前記軟磁性層裏打ち層の上に垂直磁気記録層を形成する工程と、前記最直磁気記録層の上に保護膜を形成する工程と、前記保護膜の上に液体調料材層を形成する工程と、を具えることを特徴とする垂直磁気記録媒体の製造方法。

【請求項6】 前記款磁性裏打ち層に磁場を印加する工程は、ターゲットのマグネトロンからのもれ磁場を利用することを特徴とする請求項5 に記載の金直磁気記録媒体の製造方法。

【詰求項7】 非磁性基体上に少なくとも軟磁性裏打ち層。磁気記録層、保護膜、および液体潤滑材層が順次滑層された構造を有する金面磁気記録媒体の製造方法であって、非磁性基体上に軟磁性裏打ち層を形成する工程において

非磁性基体上に軟磁性下層を形成し、同時に敏磁性下層 に基体の半径方向に平行な数10~数100Gaussの磁 場を印加する工程と、

前記軟磁性下層の上に、非磁性層を設ける工程と 前記軟磁性下層の上であり、かつ前記非磁性層の外周お よび内周側面に軟磁性層を設ける工程と、 前記非磁性圏および軟磁性圏の上に軟磁性上層を形成 し、同時に軟磁性上層に基体の半径方向に平行な数10 〜数100 Gaussの磁場を印加する工程とを具える軟磁 性裏打ち層を形成する工程と、前記軟磁性裏打ち層の上 に垂直磁気記録層を形成する工程と、前記保護膜の上に被 層の上に保護膜を形成する工程と、前記保護膜の上に被 体調管材層を形成する工程と、前記保護膜の上に被 体調管材層を形成する工程と、を具えることを特徴とす る垂直磁気記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は各種磁気記録装置に 搭載される垂直磁気記録媒体およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】磁気記録の高密度化を実現する技術とし 10 て、従来の長手磁気記録方式に代えて、垂直磁気記録方 式が注目されつつある。

【0003】垂直磁気記録媒体は、硬質磁性材料の磁気 記録層と、この記録層への記録に用いられる、磁気ヘッ ドが発生する磁束を集中させる役割を担う軟磁性材料の 裏打ち層から構成される。このような構造の垂直磁気記 録媒体において問題となるノイズの一つであるスパイク ノイズは、裏打ち層である軟磁性層に形成された磁壁に よるものであるととが知られている。磁壁形成およびノ イズ発生のメカニズムは以下の通りである。

0 【0004】基体上に

「0004】基体上に

「以びに

「ないに

「な

【0005】この教磁性裏打ち層の磁壁の抑制について 40 は、例えば、特開平6-180834号公報および特闘 平10-214719号公報に示されている。

【0006】特開平6-18083号公報には、軟磁性 裏打ち層の上層または下層にCo合金などの強磁性層を 形成し、これを所望の方向に磁化させるように着磁する 方法が記載されている。特開平10-214719号公 報には、反強磁性薄膜を形成し交換結合を利用して磁化 をピン止めする方法が提案されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上途した従来の方法の 50 ような強磁性層または反殊磁性薄膜を用いて軟磁性臭打

ち層との交換結合により磁壁の制御を行う方法は、交換 結合が十分に得られた場合。軟礎性裏打ち層の磁壁形成 を阻止することができ、非常に効果的である。しかしな がら、強磁性層を用いる場合には、所望の方向に磁化さ せることが実用的には困難であり、また反強磁性層を用 いる場合には、十分な交換結合を得るために成膜後加熱 処理が必要であるなど、いずれの方法も大量生産を行う

【①008】したがって、軟磁性裏打ち層に起因するス 産が可能な垂直磁気記録媒体およびその製造方法が必要 とされている。

#### [0009]

場合には不利であった。

【課題を解決するための手段】上記の問題を解決する手 段として、軟磁性層の磁化を環境することにより、軟磁 性層の外国部分および内閣部分での磁壁の形成を阻止し た垂直磁気記録媒体およびその製造方法を提案する。

【0010】具体的には、本発明の第1の形態の垂直磁 気記録媒体は、非磁性基体上に少なくとも軟磁性裏打ち 圏、磁気記録器、保護膜、および液体調滑材層が順次論 29 層された構造を有しており、該非磁性基体は、外周およ び内層側面に軟砂性層を形成している。

【0011】ここで、前途の歓遊性裏打ち層は、磁化容 易軸が半径方向に平行に配向していることが好ましい。 【0012】本発明の第2の形態の垂直磁気記録媒体 は、非磁性基体上に少なくとも軟磁性裏打ち層、磁気記 録者、保護順、および液体潤滑材層が順次荷層された機 造を有しており、前述の軟磁性裏打ち層が、軟磁性下 層、非磁性層、および敏酸性上層の順に積層した3層機 造をしており、該非磁性層は、前述の磁性基体の内閣よ 30 り大きき内国と、前述の非磁性基体の外周より小さい外 国とを有しており、かつ外周および内閣側面に軟磁性圏 を形成しており、該非磁性上層と非磁性下層とが、該非 磁性層の外周および内周側面に設けられた軟磁性層を介 して接続している。

【① 013】とこで、前述の軟磁性上層および軟磁性下 圏は、磁化容易軸が半径方向に平行に配向していること が好ましい。

【0014】また、上述した非磁性基体上に少なくとも **彰越性裏打ち層、磁気記録層、保護膜、および液体潤滑** 材層が順次論層された構造を有する。 本発明の第1の形 態の垂直磁気記録媒体の製造方法は、非磁性基体の外周 および内国側面に軟磁性層を設ける工程と、該非磁性基 体および軟磁性層上に軟磁性裏打ち層を形成し、同時に 0.0 Gaussの磁場を印加する工程と、該軟磁性層裏打ち 層の上に垂直越気記録層を形成する工程と、該垂直磁気 記録層の上に保護膜を形成する工程と、飲保護膜の上に 液体潤滑材層を形成する工程と、を具える。

【0015】ここで、前途の軟隘性裏打ち層に磁場を印 50 する。

加する工程は、ターゲットのマグネトロンからのもれ遊 場を利用することが好ましい。

【0016】さらに、非磁性基体上に少なくとも軟磁性 裏打ち層、磁気記録層、保護膜、および液体調管材層が 順次積層された構造を有する、本発明の第2の形態の量 直越気記録媒体の製造方法は、非磁性基体上に軟磁性基 打ち層を形成する工程において、非磁性基体上に軟磁性 下層を形成し、同時に敏磁性下層に基体の半径方向に平 行な数10~数100Gaussの磁場を印加する工程と、 パイクノイズをより容易に抑制することができ、大置生 10 該軟酸性下層の上に、非磁性層を設ける工程と、該軟酸 性下層の上であり、かつ設非磁性層の外圍および内圍側 面に軟磁性層を設ける工程と、該非磁性層および軟磁性 層の上に飮磁性上層を形成し、同時に軟磁性上層に基体

> 加する工程とを具える敏磁性裏打ち層を形成する工程 と、該軟磁性裏打ち層の上に垂直磁気記録層を形成する 工程と、該垂直磁気記録層の上に保護膜を形成する工程 と、該保護膜の上に液体潤滑材層を形成する工程と、を 具える。

の半径方向に平行な数10~数100 Gaussの磁場を印

【0017】ととで、前述の軟礎性下層および軟磁性上 屋に磁場をED削する工程は、ターゲットのマグネトロン からのもれ磁場を利用することが好ましい。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明についてより詳細に 記載する。

【0019】本発明は、垂直磁気記録媒体において、形 成される軟磁性裏打ち層に起因するスパイクノイズの発 生を抑制し、大量生産の可能な垂直磁気記録媒体および その製造方法を提供するものである。

【0020】とのような課題を解決するために、本発明 では、軟磁性裏打ち層の磁化を凝縮させることによっ て、軟磁性圏裏打ち圏の内外国部における磁型の形成を 阻止する方法を提供する。

【0021】本発明では、磁化を量流させた、2つの形 態の垂直磁気記録媒体を提供する。

【0022】本発明の第1の形態は、軟磁性裏打ち層を 成験する時に、非磁性基体の表面のみでなく、基体の内 国および外国側面にも軟磁性層を形成し、側面に形成さ れた軟磁性層を通して、基体の表から裏面へ、そして裏 49 から表面に磁化を環流させる。

【0023】本発明の第2の形態は、軟磁性裏打ち層を **軟越性下層、非越性層、および軟磁性上層の順に三層機** 造とする。ことで、非磁性層は、敏磁性上層および敏磁 性下層の外国より小さい外周と、軟磁性上層および軟磁 性下層の内閣より大きい内閣とを有する。そして、この 非磁性層の外層および内層側面に軟磁性層を形成し、こ の軟礎性圏を介して、軟礎性上層と軟礎性下層とが接触 する構造している。このようにして、軟磁性上層および 敏磁性下層の磁化は非磁性層の周囲を回転する形で最適

【0024】との第1の形態の軟磁性裏打ち層を成膜する時、および第2の形態の軟磁性上層および軟磁性下層を成膜する時には、基体面と平行の方向に数10~数100Gauss程度の磁場の印加を行い、面内で軟磁性層の磁化容易輸が半径方向に配向している。

【0025】まず、第1の形態の垂直磁気配躁媒体について図1をよび図2を容照しながらさらに説明する。

【0026】図1は、本発明における第1の形態の一例 を示す垂直磁気記録媒体の断面模式図であり、図2

(a)は、基体上に敏磁性裏打ち層を成膜したときの磁 10 化の概念図を示しており、図2(b)は、図2(a)の 2-2'の弧に対応する扇形部分の拡大図である。図中 の矢印は、磁化の方向を示している。

【① 027】図1に示す垂直磁気記録媒体は、非磁性基体1とその内層および外層側面に彰磁性層1aを設け、該非磁性基体1および彰磁性層1aの両面(一面側のみ図示)上に、軟磁性裏打ち層2、垂直磁気記録層3、および保護膜4が順に形成された構造を有しており、さらにその上に液体調滑材層5が形成されている。

【① 028】非磁性基体 1 としては、通常の磁気記録媒体用に用いられるN 1 Pメッキを施したA 1 合金、強化ガラス、または結晶化ガラスなどを用いることができる。

【0029】との非磁性基体1の内周および外周側面に 軟磁性層1 a を設け、該非磁性基体1 および軟磁性層1 aの上に軟磁性裏打ち層2を形成する。軟磁性層1 a お よび軟磁性裏打ち層2を形成方法としては、例えば、マ グネトロンスパッタ法裏たは電子ビーム蒸音法などがあ る。通常のスパッタを用いた成膜の際には、バッキング プレートなどターゲット以外からのスパッタを防止する ためにアースシールドを超し、さらに両面成膜のため対 向面のプラズマとの干渉を防止するためにシールドが施 されるが、本発明における軟磁性裏打ち層を成膜する際 には、シールドの穴を通常よりも大きくして、非磁性基 体1の外周および内園側面にも軟磁性層1 a が形成され るようにした。

【0030】また、上述以外にも、非磁性基体を回転させながら約45°までの斜め方向からスパッタすることにより、非磁性基体の表面ならびに内周および外層側面に軟磁性層1aおよび軟磁性裏打ち層2を形成すること 40ができる。

【0031】また、軟磁性裏打ち層2を成膜するときに、軟磁性裏打ち層2を配向させるために基体面と平行の方向に数10~数100Gaussの磁場を印度する。このときに磁場の印加には、スパッタに用いるターゲットのマグネトロンからのもれ磁場を利用することが好ましい。

部分の拡大図である図2(b)に示すように、非政性基体1の外国および内国側面の軟磁性層1aによって軟磁性裏打ち層2は、その磁化を遅遠させることができる。【0033】軟磁性層1aおよび軟磁性裏打ち層2の材料としては、結晶のN・Fe合金、もしくはセンダスト(FeS・A1)合金、または非晶質のCo合金であるCoZrNりなどを用いることができる。軟磁性裏打ち層2の膜厚は、記録に使用する磁気へっFの構造や特性によって最適値が変化するが、約10nm~約500nmが生産性との競ね合いより望ましい。

【0035】垂直磁気記録層3の順厚としては、特に限 定されないが、20~30nmであることが垂直方向の 異方性を維持し、かつ十分な記録磁界を得るため好まし い。

【0036】垂直磁気記録層3の上に保護艙4をマグネトロンスパッタ送またはプラズマCVD法などを用いて形成する。保護膜4としては、例えばカーボンを主体とする薄膜が用いられるが、これに限定しない。保護艙4の膜厚としては、特に限定されないが、3~7nmであることが媒体表面を保護し、かつ磁気的スペーシングを小さくするため好ましい。

30 【0037】次いで、保護機4の上に液体潤滑付層5を ディッピング法またはスピンコーティング法などを用い て形成する。液体潤滑剤としては、パーフルオロポリエーテル系を用いることができる。

【0038】とのようにして、図1に示すような層構造を有する最直磁気配線媒体を形成することができる。

【0039】次に、第2の形態の垂直磁気記録媒体について図3もよび図4を参照しながら詳細に説明する。

【0040】図3は、本発明における第2の形態の一例 を示す垂直磁気記録媒体の断面模式図であり、図4

0 (a)は、基体上に歓遊性裏打ち層を成膜したときの磁化の概念図を示しており、図4(b)は、図4(a)の4-4′の弧に対応する暴形部分の拡大図である。図中の矢印は、磁化の方向を示している。

【0041】図3に示す垂直磁気記録媒体は、非磁性基体1の両面(一面側のみ図示)上に、軟磁性臭打ち層2、垂直磁気記録層3、および保護膜4が順に形成された構造を有しており、さらにその上に液体潤滑材層5が形成されている。ここで、軟磁性臭打ち層2は、軟磁性下層2a、非磁性層2b、および改磁性上層2cを順に

は、軟磁性下層2aおよび軟磁性上層2cの外層よりも 小さな外国と、軟磁性下層2a および軟磁性上層2cの 内閣よりも大きな内閣を有する。そして、非磁性層2 b は、その外周および内周側面に軟磁性層20を有し、こ の軟磁性層2dを介して軟磁性下層2aおよび軟磁性上 屋2cは接続している。

【0042】非磁性基体1としては、通常の磁気記録媒 体用に用いられるN , Pメッキを施したA ! 台金. 強化 ガラス、または結晶化ガラスなどを用いることができ る。

【0043】との非磁性基体1上に、マグネトロンスパ ッタ法または電子ビーム蒸着法などを用いて敏越性下層 2aを形成する。敏磁性下層2aを成膜するときに、軟 磁性下層2aを配向させるために基体面と平行の方向に 数10~数100Gaussの磁場を印加する。このときに 磁場の印加には、スパッタに用いるターゲットのマグネ トロンからのもれ磁場を利用することが好ましい。

【0044】軟磁性下層2aの膜厚は、50~300n mであることが好ましい。

2 b をマグネトロンスパッタ法または電子ビーム蒸音法 などを用いて形成する。このときに軟砂性下層2aの外 国および内国端部まで非磁性圏2 りが形成されないよう に、軟磁性下層2aの外周および内周部にマスキングを する。

【0046】非磁性層2bとしては、Ta、Cr. C u、Ti、C、またはMoなどが挙げられ、その膜厚 は、1~15 n mが好ましい。

【0047】次にマスキングを取り除き、非磁性層2ヵ の外層および内層側面に軟磁性層2 d と、非磁性層2 b および敏磁性層20の上に軟磁性上層2cをマグネトロ ンスパッタ法または電子ビーム蒸着法を用いて形成す る.

【0048】軟磁性上層2cを成膜するときに、軟磁性 上層2aを配向させるために基体面と平行の方向に数1 ○~数100Gaussの磁場を印制する。このときに磁場 の印加には、スパッタに用いるターゲットのマグネトロ ンからのもれ磁場を利用することが好ましい。

【0049】軟磁性上層2 cの膜厚は、50~300 n 血であることが好ましい。

【0050】とのように形成された軟磁性裏打ち層2 は、図4 (a) に示すように、半径方向に遊化容易軸を 有する。また、図4 (a) の4-4′ 弧に対応する扇形 部分の拡大図である図4 (b) に示すように、非磁性層 2 b と、その外層および内層側面に形成された軟磁性層 2 dによって軟磁性裏打ち層2は、その磁化を遏流させ るととができる。

【0051】軟磁性下層2a、軟磁性層2d、および軟 磁性上層2cの材料としては、結晶のN:Fe合金、も しくはセンダスト (FeSiA!) 合金、または非晶質 50 【0060】 このようにして、本発明の第1の形態の量

のCo台金であるCo2rNbなどを用いることができ る。軟磁性裏打ち層2の競厚は、記録に使用する磁気へ ッドの模造や特性によって最適値が変化するが、約10 nm~約500nmが生産性との兼ね合いより望まし

【0052】次いで、敦磁性裏打ち層2の上に第1の形 底の場合と同様にして、垂直磁気記録層3、保護膜4、 および液体潤滑村圏5を設ける。

【0053】とのようにして、図3に示すような層標造 を有する垂直磁気記録媒体を形成することができる。

【0054】なお、本発明の第1の形態および第2の形 底において、軟砂性裏打ち層2と垂直砂気記録層3との 間に、金直磁気記録層3の結晶配向性および結晶粒径を 好ましく制御するために、例えば、TiまたはTiCr 台金からなる下地層(図示せず)を設けることもでき る。

【0055】また、上述に本発明の第1および第2の形 態の垂直磁気記録媒体において、好ましい製造方法と共 にその構成を記載したが、これらに限定されず、軟磁性 【0045】次いで、該軟磁性下層2a上に、非磁性層 20 裏打ち層を還流する構造を形成させることが本発明では 最も重要である。

> 【0056】 [実施例] 以下に本発明の実施例を示す。 【0057】[実施例1]本実施例では本発明の第1の 形態の垂直磁気記録媒体を製造した。

【0058】非磁性基体1として表面が平滑な化学強化 ガラス基板 (HOYA社製N-10ガラス基板) を用 い、これを洗浄後スパッタ装置内に導入した。引き続い てCotoCrsNbターゲットを用いてCoZrNb非 晶質軟磁性裏打ち層2を200ヵm成膜した。軟磁性裏 - 打ち屠を配向させるために基体面と平行方向に数10~ 数100 Gauss程度の磁場を印加する必要があるが、と れにはターゲットのマグネトロンからのもれ磁場(約1 (1) Gauss) を利用した。また、軟磁性裏打ち層2の成 膜の際には、シールドの穴を通常よりも大きめにし、非 磁性基体 1の外層部および内層部側面にも軟磁性層 1 a が形成されるようにした。このようにして軟磁性裏打ち 層2を成膜した場合の層構造と磁化の概念は図2に示し た消りである。

【0059】引き続いてランプヒータを用いて基体表面 40 温度が250℃になるように加熱を行った後、Tiター ゲットを用いてT・下地膜10nm(図示せず)を成膜 した。引き続きCox。CrxePtターゲットを用いて膜 厚30nmのCoCrPt磁気記録署3を成膜し、最後 にカーボンターゲットを用いてカーボンからなる瞬厚! Onmの保護膜4を成膜後、真空装置から取り出した。 これらの各層の成膜はすべてArガス圧5mTorr下 でDCマグネトロンスパッタリング法により行った。そ の後、パーフルオロボリエーテルからなる腹厚2nmの 液体潤滑材層5をディップ法により形成した。

10

直磁気記録媒体を形成した。

【0061】得られた量直磁気記録媒体の軟磁性裏打ち 層2に形成される磁壁の有無を確認するために、スピン スタンドテスターを用いて記録密度50kFC1の信号 をMRヘッドにより書き込み、その再生波形を観察する ことで、スパイクノイズの有景を調べた。

\*【0062】表 1 に、再生波形に表れるスパイクノイズ の個数を示す。非磁性基体1の内外周側面部に軟磁性膜 1 a を形成することにより磁壁の形成が阻止され、スパ イクノイズの発生が抑制されていることがわかる。

[0063]

【表1】

例	原務成	スパイクライズ (値)
実施例 1	基本(制面鋁Co <sub>n</sub> ,Zr <sub>2</sub> ,Nb)/Co <sub>n</sub> ,Zr <sub>2</sub> ,Nb/Tī <sub>2</sub> / Co <sub>n</sub> ,Cr <sub>1</sub> ,Pt./C./Li <sub>1</sub> b*	0
実施例2	基体(机面解 Ni <sub>Z</sub> Fe) / Ni <sub>Z</sub> Fe · Ti / Co <sub>Z</sub> Cr <sub>10</sub> Pt / C / Lub	O
実施例3	基体/Co <sub>2</sub> Zr <sub>2</sub> Nb/Or(加語語 Co <sub>22</sub> Zr <sub>2</sub> Nb)/ Co <sub>22</sub> Zr <sub>3</sub> Nb/Ti/Co <sub>22</sub> Cr <sub>30</sub> Pt/C/Lub	0
比較例1	坐体/Cc <sub>12</sub> Zr <sub>2</sub> Nb/Ti/Co <sub>22</sub> Cr <sub>22</sub> Pt/C/Lub	>10

Lub':パーフルオロボリエーテルからなる液体潤滑材層 【0064】[比較例1]軟磁性裏打ち圏2を形成する 裏打ち囲2を非磁性基体1の上にのみ形成すること、す なわち、非磁性基体1の外周および内周側面に軟磁性層 laを形成しないことを除いて、実施例1と同様にして 垂直磁気記録媒体を製造した。

【0065】得られた垂直磁気記録媒体について、実施 例1と同様にしてスパイクノイズの有無をを調べた。 結 具を表1に記載する。

【0066】 [実施例2] 本実施例では、本発明の第1 の形態の豊直磁気記録媒体を製造した。

【0067】軟磁性裏打ち磨2および軟磁性層1aの形 成の際に、Niュ、Fe合金ターゲットを用いたこと以外 は、実施例1と同様にして本発明の第1の形態の垂直磁 気記録媒体を形成した。

【0068】得られた垂直磁気記録媒体について、実施 例1と同様にして、スパイクノイズの有魚を調べた。結 果を表1に示す。実施例1と同様に、磁壁の形成が阻止 され、スパイクノイズの発生が抑制されていることがわ かる。

【①069】〔実施例3〕本実施例では、本発明の第2 の形態の垂直磁気記録媒体を製造した。

【0070】非磁性基体として表面が平滑な化学強化ガ ラス基板 (HOYA社製N-10ガラス基板)を用い、 これを洗浄後スパッタ装置内に導入した。引き続いてC o.e.ZriNbターゲットを用いて、膜厚100nmの CoArNb非晶質軟磁性下層2aを形成した。次に、 軟磁性下層2aの内間および外間のそれぞれから約2m mまでの範囲をマスキングして、Cェターゲットを用い て膜厚5nmのCr非磁性層2bを形成した。次いで、 マスキングを取り除き、Coi。2g。Nbターゲットを 用いて非磁性層2 b の外周および内閣側面部に軟磁性層 50 ことができる。軟磁性層の磁化容易軸は半径方向へ配向

2dと、順厚200nmのCo2rNb非晶質軟磁性上 層2cを形成した。敏磁性の各層は、その成膜の際に、 段に、シールドの穴を通常と同様の大きさにし、軟磁性 20 実施例1と同様にしてターゲットのマグネトロンからの もれ磁場を利用することによって、磁化を基体面と平行 方向に配向させた。

> 【0071】これらの各層の成膜は全てArガス圧5m Torr下で、DCマグネトロンスパッタ法により行っ

> 【0072】 このようにして軟磁性裏打ち圏2を形成し た場合の層構造と、磁化の概念は図4に示した通りであ る.

【0073】引き続き、実施例1と同様にしてAェガス 圧5mTorr下で、DCマグネトロンスパッタリング 30 法により、厚さ10nmのTi下地層(図示せず)、膜 厚30mmのCo.。Cr.。Pt 金直磁気記録層3. およ び膜厚10mmのカーボン保護膜4を形成した。次い で、真空装置から取り出した媒体上に、パーフルオロボ リエーテルよりなる、膜厚2mmの液体調滑材膏5をデ ィップ法により形成した。

【0074】とのようにして、本発明の第2の形態の垂 直磁気記録媒体を製造した。

【0075】実能例1と同様にして、得られた垂直磁気 40 記録媒体のスパイクノイズの有無を調べた。結果を表 1 に示す。

【0076】本実施例に示した方法でも、実施例188よ び実能例2と同様に磁壁の形成が阻止され、スパイクノ イズの発生が抑制されていることがわかる。

[0077]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、飲 磁性裏打ち圏の磁化を、基体の表面から裏面、または非 磁性層を挟んだ軟磁性層の2層間で遠流させることで、 ノイズ源となる軟磁性裏打ち層の磁管形成の抑止を行う

12

させる必要があるが、実験例で取り上げたような軟磁性体では具方性が小さいため、ターゲットのマグネトロンの煽和磁場で十分であり、特に外部磁場を印加する必要がなく、非常に容易な方法で実行可能である。また、反磁磁性圏を用いる従来の方法と比較しても、熱処理などの必要がないことから、大量生産にも非常に適している。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の形態の一例を示す垂直磁気記録 媒体の層構成を示す筋面模式図である。

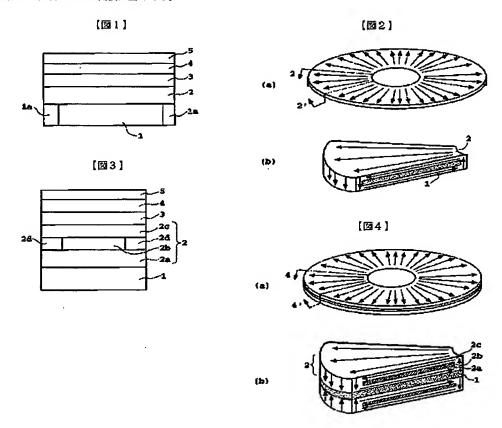
【図2】(a) は本発明の第1の形態の一例を示す豊直 磁気記録媒体のうち、非磁性基体上に軟磁性裏打ち層を 設けたときの磁化の概念図であり、(b)は、(a)の 2-2′の弧に対応する扇形部分の拡大図である。

【図3】本発明の第2の形態の一例を示す豊直越気記録 媒体の層構成を示す筋面模式図である。 \*【図4】(a)は本発明の第2の形態の一例を示す垂直 磁気記録媒体のうち、非磁性基体上に軟磁性裏打ち層を 設けたときの磁化の概念図であり、(b)は、(a)の 4-4′の弧に対応する扇形部分の拡大図である。

# 【符号の説明】

(7)

- 1 非磁性基体
- la 軟磁性層
- 2 軟磁性裏打ち圏
- 2 a 軟磁性下層
- 19 2 b 非磁性層
  - 2 c 軟磁性上層
  - 2 d 軟磁性層
  - 3 量值磁気記錄層
  - 4. 保護膜
  - 5 液体源滑衬屋



# **BEST AVAILABLE COPY**